



1) Активная поверхность, 2) Стекло



Electrical data

Время программирования	для 1x8 бит: 0,3 с для 32x8 бит: 0,6 с
Время считывания	для 32x8 бит: 0,19 с
Структура памяти	32 × 8 бит
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	до 70 °C: 500 000 до 30 °C: 1 000 000

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	10...70 °C
Температура хранения	10...126 °C
Температурный градиент, макс.	6 K/min

Functional Characteristics

Данные пользователя, чтение/запись	511 Byte
Тип памяти	EEPROM

General data

EN 55011	Гр. 1, класс А
Обессоленная вода	выдерживает
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus WEEE
Форма антенны	круглая

Material

Материал корпуса	Стекло
------------------	--------

Mechanical data

Давление, макс.	2.6 bar
Размеры	Ø 11 x 13 мм
Снаряженная масса	0.90 g
Установка	без металла (свободная зона) на металл заподлицо в металл

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-121-04/L-SA1
Код заказа: BIS000W

BALLUFF

Remarks

Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 / BIS C-6xx и подходящей для него головкой записи/считывания/

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.

Указание времени, включая контроль данных.

IP68 проверка по BWN Pr 36

На последней странице можно использовать только 31x8 бит.

Расстояние записи / считывания (см. BIS C-121-04/L) уменьшено на 0,8 мм.